

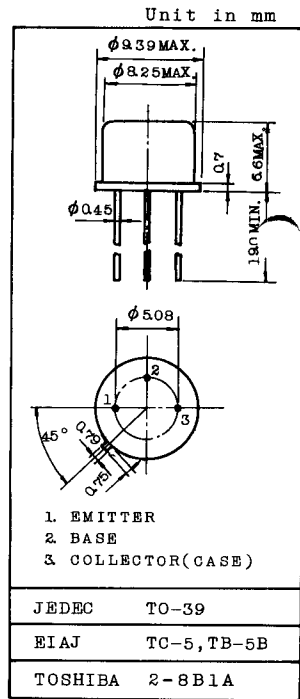
2SC497
2SC498

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 中電力増幅用
- Medium Power Amplifier Applications.
- ・ 高耐圧です。 $V_{CE0} = 80V$ (2SC497)
- ・ 飽和電圧が低い $V_{CE(sat)} = 0.2V$ (Typ)
- ・ 2SA497, 2SA498 とコンプリメンタリになります。
- ・ Complementary to 2SA497 and 2SA498.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース 間電圧	2SC497	V_{CE0}	100	V
	2SC498		80	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SC497	V_{CE0}	80	V
	2SC498		50	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EB0}	5	V
コレクタ電流		I_C	800	mA
エミッタ電流		I_E	-800	mA
コレクタ損失		P_C	600	mW
接合温度		T_j	150	$^\circ C$
保存温度		T_{stg}	-65 ~ 150	$^\circ C$



※PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	ICBO	V _{CB} = 30V, I _E = 0	—	—	1.0	μA
エミッタしや断電流	IEBO	V _{EB} = 5V, I _C = 0	—	—	1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SC497 2SC498	V _{(BR) CEO} I _C = 10mA, I _B = 0	80	—	—	V
			50	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	V _{(BR) EBO}	I _E = 1mA, I _C = 0	5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) h _{FE} (1)	V _{CE} = 2V, I _C = 200mA	40	—	240	
	h _{FE} (2)	V _{CE} = 2V, I _C = 800mA	13	—	—	
トランジション周波数	f _T	V _{CE} = 10V, I _E = 10mA	—	50	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = 10V, I _E = 0, f = 1MHz	—	15	—	pF
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 200mA, I _B = 20mA	—	0.2	0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = 200mA, I _B = 20mA	—	0.8	1.2	V

Note : h_{FE}(1)により下表のように分類し、現品表示してあります。

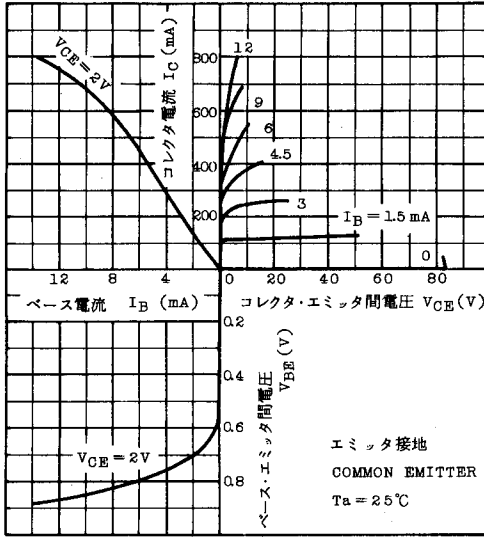
According to the value of h_{FE}(1), the 2SC497 and 2SC498 are classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC497 - R	40	80
2SC498 - R		
2SC497 - O	70	140
2SC498 - O		
2SC497 - Y	120	240
2SC498 - Y		

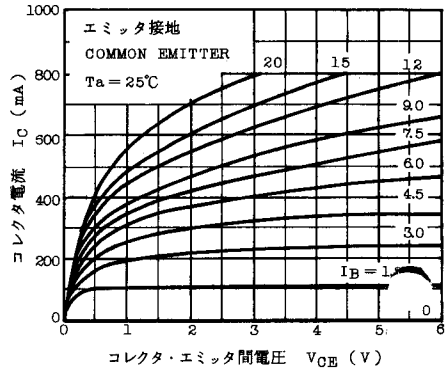
2SC497

2SC498

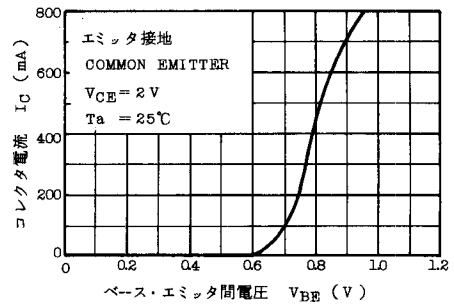
STATIC CHARACTERISTICS



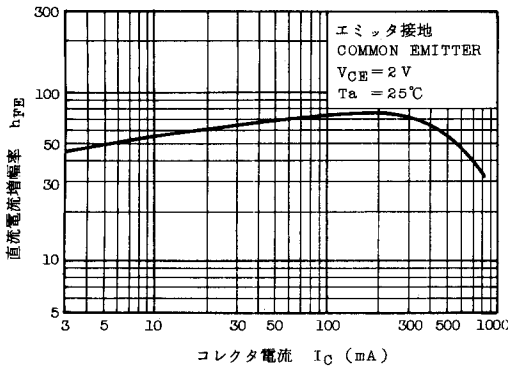
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



$I_C - V_{BE}$



$h_{FE} - I_C$



$P_C - T_a$

